

Rys. 1-729. GF100

Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy p-n-p w obudowie metalowej, ciężar około 0,4 G

Zastosowanie: układy wzmacniające pośredniej częstotliwości w odbiornikach AM

Typy podobne: 2SA12 (Hit), 155NU70 (Tes), EFT306 (Rum), OC45 (Ph), OC612 (Tel), MII15A (ZSRR)

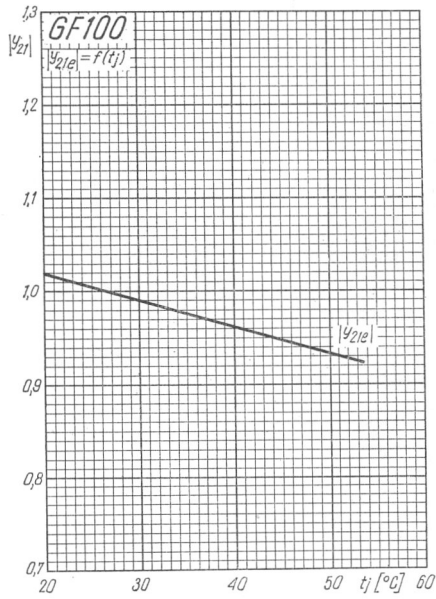
Wartości charakterystyczne¹⁾

	min	typ	max		
$-I_{CB0}$		1,5	10	μA	przy $-U_{CB} = 6 V$
$-I_{CB0}$		50	500	μA	przy $-U_{CB} = 15 V$
$-I_{CE0}$		85	600	μA	przy $-U_{CE} = 6 V$
$-I_{CES}$			25	μA	przy $-U_{CE} = 6 V$
$-I_{EB0}$			500	μA	przy $-U_{EB} = 10 V$
f_{h21b}	3	5		MHz	przy $-U_{CE} = 6 V, -I_C = 1 mA, f = 3 MHz$
h_{21E}	20		70		przy $-U_{CE} = 6 V, -I_C = 2 mA, f = 1 kHz$
F		6	15	dB	przy $-U_{CE} = 6 V, -I_C = 0,5 mA,$ $f = 0,5 MHz, R_g = 1 k\Omega$
g_{11e}		0,5	1,4	mS	} przy $-U_{CE} = 6 V, -I_C = 0,5 mA,$ $f = 0,5 MHz$
c_{11e}		300	1000	pF	
g_{12e}		3	7	μS	
c_{12e}		7	14	pF	
y_{21e}	13	17,5		mS	
g_{22e}		30	50	μS	
c_{22e}		25	50	pF	

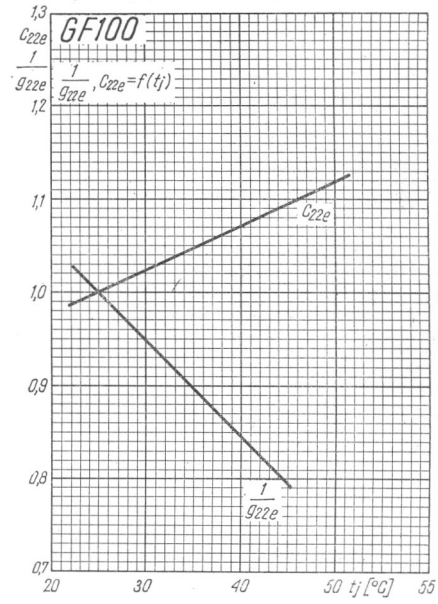
Wartości graniczne

$-U_{CB0} \max$	15	V	$-I_B \max$	5	mA
$-U_{EB0} \max$	10	V	$t_j \max$	75	$^{\circ}C$
$-I_C \max$	15	mA	t_{amb}	-40 ÷ +65	$^{\circ}C$
$I_E \max$	15	mA	$R_{thj-a} \max$	0,5	$^{\circ}C/mW$

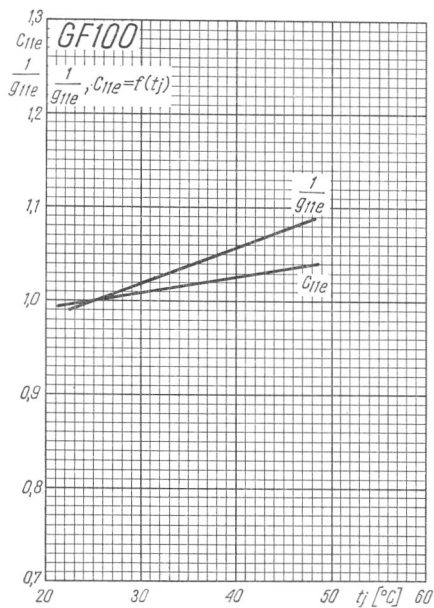
¹⁾ $t_{amb} = 25^{\circ}C (\pm 5^{\circ}C)$



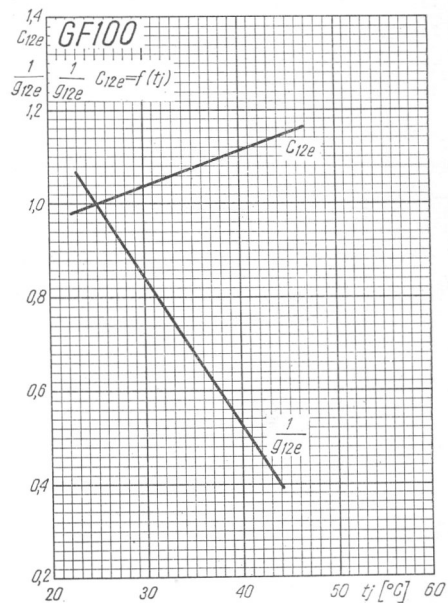
Rys. 1-730. Zależność parametru γ_{21e} od temperatury złącza



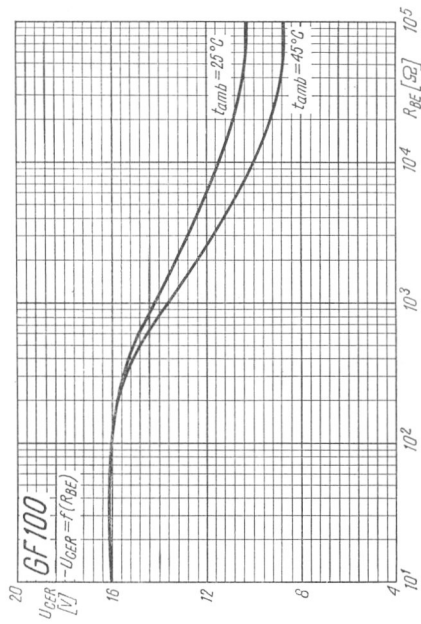
Rys. 1-731. Zależność parametrów C_{22e} i g_{22e} od temperatury złącza



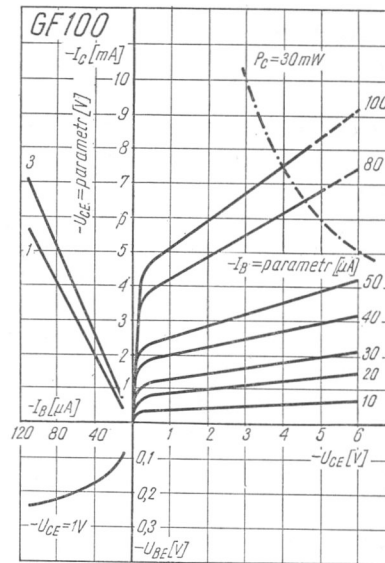
Rys. 1-732. Zależność parametrów C_{11e} i g_{11e} od temperatury złącza



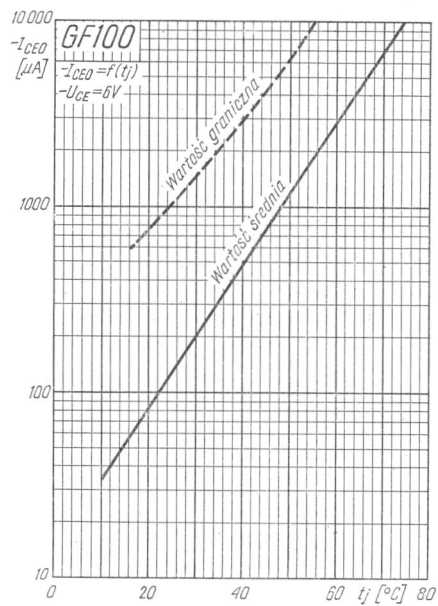
Rys. 1-733. Zależność parametrów C_{12e} i g_{12e} od temperatury złącza



Rys. 1-734. Zależność napięcia kolektora od rezystancji R_{BE}



Rys. 1-735. Charakterystyki statyczne



Rys. 1-736. Zależność prądu zerowego kolektora od temperatury złącza